

[課題番号] 21014

**過酷環境に対応可能な新規パワーFET デバイスの創出**  
**Fabrication of advanced power FET devices for harsh environment application**

学術論文（査読あり）

[1] T. Kawae, H. Okazaki, and T. Yamaki, “Fabrication of advanced power FET devices for harsh environment applications,” QST Takasaki Annual Report 2020, **1-10**, pp 35, (2021).

卒業論文

[1] 高橋克弥、「ダイヤモンド FeFET の高強度ガンマ線照射耐性に関する基礎検討」、金沢大学理工学域 電子情報通信学類

国内会議

[1] 高橋克弥、水戸守輝、山河智哉、松本翼、徳田規夫、岡崎宏之、八巻徹也、川江健、「強誘電体キャパシタに対する高強度ガンマ線照射耐性の検証」、第 6 回有機・無機エレクトロニクスシンポジウム